

集束イオンビーム加工装置 (SMI 3050)

薄膜デバイスをはじめ、多種多様な素材の高分解能観察・加工・各種試料作製といった多目的ニーズに応える次世代の FIB 装置で、断面加工・観察や任意箇所の試料切り出し加工を高精度・高速度で行うことができます。自動加工ソフトウェアにより、高精度・高スループットの TEM 試料作製などを行うことができます。また、マイクロ・プロービングシステムを装着しており、イオンビーム照射領域の試料表面にコンタクトすることができ、また試料表面にプローブをコンタクトした状態で傾斜することにより、異なる角度からイオンビーム照射を行うことができるため、自由度の高い操作が可能です。



主な仕様

項目		内容
イオンビーム光学系	二次電子像分解能	4nm
	最大プローブ電流密度	30 A/cm ² 以上
	最大プローブ電流	20 nA
	加速電圧	5~30 kV 5kV ステップ設定
	イオン源	ガリウム液体金属ニードル型イオン源
試料ステージ	最大試料寸法	50mm 角、厚さ 12mm
	ユーセントリックチルト	
	5 軸モータ駆動	X, Yフィードバック制御
アプリケーション加工		断面観察用加工 TEM観察用試料作製 プログラム加工